

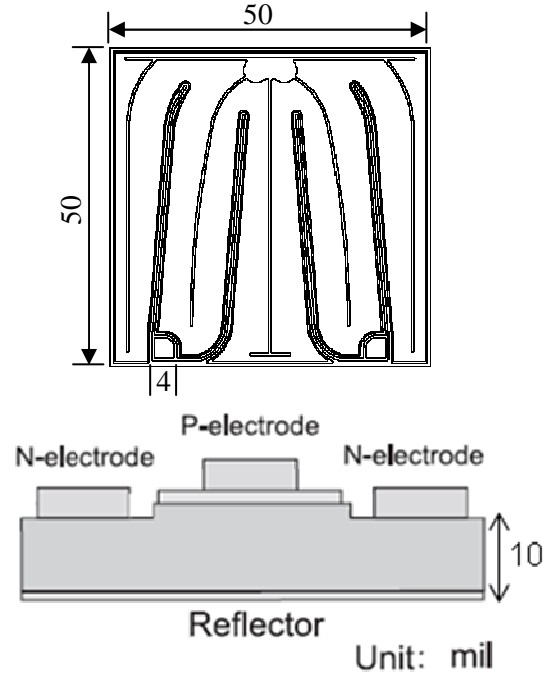


◆ 产品特点:

- 高亮度、长寿命
- 户内外应用
- 芯片百分百测试分选
- 波长和光强良好一致性

◆ 物理参数:

P 电极	金
N 电极	金
芯片尺寸	50mil × 50mil (1270±10μm×1270±10μm)
芯片厚度	10mil (250 ± 15μm)
焊盘尺寸	4mil (100 ± 10μm) in diameter



◆ 光电参数: (Tc=22°C, I<sub>F</sub>=350mA)

产品型号	波长范围 (λ <sub>D</sub> , nm)		工作电压 (V <sub>F</sub> , V)	反向漏电流 (I <sub>R</sub> , μA) @V <sub>R</sub> =5V	半波宽度 (Δλ, nm)	最大电流 (I <sub>F</sub> , mA) DC
	Min	Max				
S-50BBMUP*-445E**	445	450	≤3.6	≤2	≤35	700
S-50BBMUP*-450E**	450	455				
S-50BBMUP*-455E**	455	460				
S-50BBMUP*-460E**	460	465				
S-50BBMUP*-465E**	465	470				

◆ 光强等级: (Tc=22°C, I<sub>F</sub>=350mA)

等级	.....	CW03	CW04	CW05	CW06	CW07	CW08	.....
Power (mW)	.....	260-290	290-320	320-350	350-380	380-410	410-440	.....

◆ 其它说明:

- 光电参数均系三安光电测试仪器在晶圆条件下的测试参数, 98%符合标称值范围
- 芯片封装工艺最高温度低于 280°C, 持续时间小于 10 秒
- GaN LED 芯片为静电敏感产品, 使用、运输时注意静电防护
- 主波长测量误差 ±1.0nm
- 可根据客户需要订做特殊规格的芯片